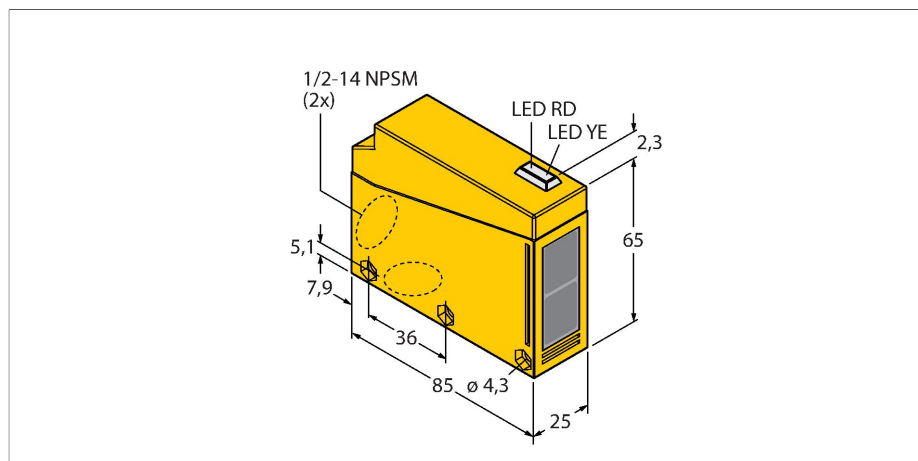


Q853E-B

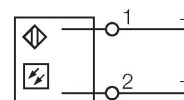
Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (излучатель)



Свойства

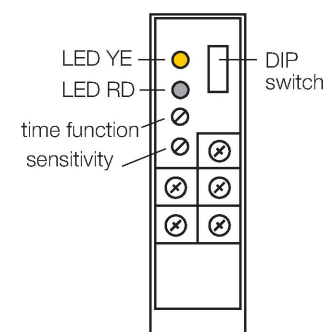
- Встроенная клеммная коробка
- Кабельные сальники, смещенная установка на 90° в двух местах
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 12...240 В DC, 24...240 В AC

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	Q853E-B
ID №	3031649
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передачик
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...23000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...240 В =
Рабочее напряжение	24...240 В AC
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 3000 мА
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 3000 мА
Задержка готовности	≤ 0 мс
Время отклика типовое	< 20 мс
Параметр настройки	Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, Q85
Размеры	85 x 65 x 25 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	акрил, Акрил
Электрическое подключение	Клеммный блок
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-25...+55 °C
Степень защиты	IP67



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из автономных излучателя и приемника. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучатель попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и очень высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях, наприим. при загрязнении линз или смещении элементов датчика.

Технические характеристики

Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	

